# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-271786

(43)Date of publication of application: 27.09.1994

(51)Int.CI.

CO9B 67/50

G03G 5/06

G03G 5/06

(21)Application number: 05-058511

(71)Applicant : HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

18.03.1993

(72)Inventor: MATSUI MEGUMI

HAYASHIDA SHIGERU

AKIMOTO TAKAYUKI

ITAGAKI MIKIO

(54) PHTHALOCYANINE COMPOSITION, ITS PREPARATION, AND ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR AND COATING FLUID FOR CHARGE GENERATING LAYER WHICH ARE MADE BY USING THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a phthalocyanine composition excellent in charge build-up

characteristics, dark decay, and sensitivity.

CONSTITUTION: To produce a phthalocyanine composition having main diffraction peaks at Bragg angles ( $2\theta\pm0.2^{\circ}$ ) of 7.5°, 24.2° and 27.3° in the X-ray diffraction spectrum by using Cu Klpha radiation, a phthalocyanine mixture containing titanylphthalocyanine and a halogenated metal phthalocyanine whose central metal is trivalent is precipitated in water by the acid pasting method to give a precipitate having a characteristic diffraction peak at a Bragg angle ( $2\theta\pm0.2^{\circ}$ ) of 27.2° in the X-ray diffraction spectrum by using Cu K lpha radiation, and this precipitate is treated with a mixture of an aromatic organic solvent and water. This composition is used to produce an electrophotographic photoreceptor and a coating fluid for a charge generating layer.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.10.1999

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3343275

[Date of registration]

23.08.2002

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-271786

(43)公開日 平成6年(1994)9月27日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

C 0 9 B 67/50 G03G 5/06 Z 7306-4H

9221-2H 3 1 2

9221-2H 371

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 18 頁)

(21)出願番号

特願平5-58511

(71)出願人 000004455

日立化成工業株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

(22)出願日

平成5年(1993)3月18日

(72)発明者 松井 恵

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化

成工業株式会社茨城研究所内

(72)発明者 林田 茂

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化

成工業株式会社茨城研究所内

(72)発明者 秋元 孝幸

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化

成工業株式会社茨城研究所内

(74)代理人 弁理士 若林 邦彦

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 フタロシアニン組成物、その製造法、これを用いた電子写真感光体および電荷発生層用塗液

(57)【要約】

【目的】 帯電性、暗減衰、感度に優れたフタロシアニ ン組成物のを提供する。

【構成】 CuKaのX線回折スペクトルにおいてブラ ッグ角 (2 θ ± 0. 2度) の 7. 5度、 2 4. 2度およ び27.3度に主な回折ピークを有するフタロシアニン 組成物、チタニルフタロシアニンおよび中心金属が3価 のハロゲン化金属フタロシアニンを含むフタロシアニン 混合物を、アシッドペースティング法により水中に沈殿 させ、 $CuK\alpha$ のX線回折スペクトルにおいてブラッグ 角(2 $\theta$ ±0.2度)27.2度に特徴的な回折ピーク を有する沈殿物を得、引き続きこの沈殿物を、芳香族系 有機溶剤-水の混合溶媒で処理することを特徴とするC  ${\bf u}$  K  ${f lpha}$ のX線回折スペクトルにおいてブラッグ角(2  ${f heta}$ ±0.2度)の7.5度、24.2度および27.3度 に主な回折ピークを有するフタロシアニン組成物の製造 法、前記フタロシアニン組成物を用いた電子写真感光体 および電荷発生層用塗液。

#### 【特許請求の範囲】

CuKαのX線回折スペクトルにおいて 【請求項1】 ブラッグ角(2θ±0.2度)の7.5度、24.2度 および27.3度に主な回折ピークを有するフタロシア ニン組成物。

【請求項2】 チタニルフタロシアニンおよび中心金属 が3価のハロゲン化金属フタロシアニンを含むフタロシ アニン混合物を、アシッドペースティング法により水中 に沈殿させ、CuKαのX線回折スペクトルにおいてブ ラッグ角(2θ±0.2度)27.2度に特徴的な回折 ピークを有する沈殿物を得、引き続きこの沈殿物を、芳 香族系有機溶剤ー水の混合溶媒で処理することを特徴と するCuKαのX線回折スペクトルにおいてブラッグ角 (2θ±0.2度)の7.5度、24.2度および2 7. 3度に主な回折ピークを有するフタロシアニン組成 物の製造法。

芳香族系有機溶剤と水の混合比率が芳香 【請求項3】

族系有機溶剤/水=1/99~99/1であることを特 徴とする請求項2記載のフタロシアニン組成物の製造 法。 【請求項4】 導電性基材上に有機光導電性物質を含有 する光導電層を有する電子写真感光体において、この有

機光導電性物質がСυΚαのΧ線回折スペクトルにおい てブラッグ角(2θ±0.2度)の7.5度、24.2 度および27.3度に主な回折ピークを有するフタロシ アニン組成物である電子写真感光体。

【請求項5】 フタロシアニン組成物が、その吸収スペ クトルにおいて、800~830nmの吸光度が620~ 6 6 0 nmの吸光度より大きいものである請求項 4 記載の 電子写真感光体。

【請求項6】 請求項1記載のフタロシアニン組成物を 電荷発生材料として含有する電荷発生層と、下記の一般 式[1]

【化1】

$$(R_1)_r - A_{r_1}$$
 $(R_2)_s - A_{r_2}$ 
 $R_3$ 
 $R_4$ 
 $A_{r_1} - (R_1)_p$ 
 $A_{r_2} - (R_2)_q$ 
 $A_{r_3} - (R_2)_q$ 

 $(R_1 及び R_2$ は、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン 原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、フルオ ロアルキル基又はフルオロアルコキシ基を表し、2個の  $R_3$ は、それぞれ独立して水素原子又はアルキル基を表 し、 $Ar_1$ 及び $Ar_2$ は、それぞれ独立してアリール基を 表し、p、q、r及びsは、それぞれ独立して $0\sim5$ の 整数を示す) で表されるベンジジン誘導体を電荷輸送物 質として含有する電荷輸送層を有する複合型電子写真感

【請求項7】 請求項1のフタロシアニン組成物を含有 する電荷発生層用塗液。

【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、高い感度を有する新規 なフタロシアニン組成物、その製造法、それを用いた電 子写真感光体および電荷発生層用塗液に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来の電子写真感光体としては、アルミ ニウム等の導電性基板の上に 5 0 μ m程度のセレン(S e) 膜を真空蒸着法により形成したものがある。しか し、このSe感光体は、波長500nm付近までしか感度 を有していない等の問題がある。また、導電性基板の上 に50μm程度のSe層を形成し、この上に更に数μm のセレンーテルル (Se-Te) 合金層を形成した感光 体があるが、この感光体は上記Se-Te合金のTeの 含有率が高い程、分光感度が長波長にまで伸びる反面、 T e の添加量が増加するにつれて表面電荷の保持特性が 不良となり、事実上、感光体として使用できなくなると いう重大な問題がある。

【0003】また、アルミニウム基板の上に1μm程度 のクロロシアンブルー又はスクウアリリウム酸誘導体を コーティングして電荷発生層を形成し、この上に絶縁抵 抗の高いポリビニルカルバソール又はピラソリン誘導体 とポリカーボネート樹脂との混合物を10~20μmコ ーティングして電荷輸送層を形成した所謂複合二層型の 感光体もあるが、この感光体は700㎜以上の光に対し て感度を有していないのが実状である。

【0004】近年、この複合二層型の感光体において、 上記欠点を改善した、即ち、半導体レーザ発振領域80 Onm前後に感度を有する感光体も多く報告されている が、これらのうち多くのものが電荷発生材料としてフタ ロシアニン顔料を用い、その膜厚 0. 5~1μm程度の 電荷発生層上にポリビニルカルバソール、ピラソリン誘 導体又はヒドラゾン誘導体とポリカーボネート樹脂又は ポリエステル樹脂との絶縁抵抗の高い混合物を10~2 0 μ m コーティングして電荷輸送層を形成し複合二層型 の感光体を形成している。

【0005】フタロシアニン類は、中心金属の種類によ り吸収スペクトルや、光導電性が異なるだけでなく、結 晶型によってもこれらの物性には差があり、同じ中心金 属のフタロシアニンでも、特定の結晶型が電子写真用感 光体用に選択されている例がいくつか報告されている。

【0006】例えばチタニルフタロシアニンには種々の 結晶形が存在し、その結晶形の違いによって帯電性、暗 減衰、感度等に大きな差があることが報告されている。 【0007】特開昭59-49544号公報には、チタ ニルフタロシアニンの結晶形としては、ブラッグ角(2 θ±0.2度) の9.2度、13.1度、20.7度、 26. 2度、27. 1度に強い回折ピークを与えるもの が好適であることが示されており、X線回折スペクトル 図が示されている。この結晶形のチタニルフタロシアニ ンを電荷発生材料として用いた感光体の電子写真特性 は、暗滅衰(DDR):85%、感度(E<sub>1/2</sub>):0. 5 7 lux secである。

【0008】また特開昭59-166959号公報に は、チタニルフタロシアニンの蒸着膜をテトラヒドロフ ランの飽和蒸気中に 1~24時間放置し、結晶形を変化 させて、電荷発生層としている。X線回折スペクトル は、ピークの数が少なく、かつ幅が広く、ブラッグ角 (2θ±0.2度) の7.5度、12.6度、13.0 度、25.4度、26.2度および28.6度に強い回 折ピークを与えることが示されている。この結晶形のチ タニルフタロシアニンを電荷発生材料として用いた感光 体の電子写真特性は、暗滅衰(DDR):86%、感度 (E<sub>1/2</sub>) : 0. 7 lux secである。

【0009】特開平2-198452号公報には、チタ ニルフタロシアニンの結晶形としては、ブラッグ角(2  $\theta\pm0$ . 2度) の27. 3度に主たる回折ピークを有す るものが高感度(1. 7 mJ/m²)であり、その製造法と して水とオルトージクロロベンゼン混合液中で60℃1 時間加熱撹拌することが示されている。

【0010】特開平2-256059号公報には、チタ ニルフタロシアニンの結晶形として、ブラック角 (2θ ±0.2度)の27.3度に主たる回折ピークを有する ものが高感度 (O. 6 2 lux sec) であり、その製造法 として室温下1,2-ジクロロエタン中で撹拌すること が示されている。

【0011】このように、フタロシアニン類は結晶形の 違いによって電子写真特性が大きく異なり、その結晶形 が電子写真感光体としての性能を左右する重要な因子で ある。

【0012】特開昭62-194257号公報には、2 種以上のフタロシアニンを混合して用いる例、例えば、 チタニルフタロシアニンと無金属フタロシアニンの混合 物を電荷発生材料として用いることが示されている。

【0013】このようにチタニルフタロシアニンは結晶 形変換によって非常に感度が高く、優れた特性を示して いる。しかし、その用途であるレーザプリンタ等では、 高画質、高精細化が進んでおり、更に高感度な特性を有 する電子写真感光体が求められている。

#### [0014]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、高い感度を 有するフタロシアニン組成物、その製造法、それを用い た電子写真感光体および電荷発生層用塗液を提供するも

のである。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明は、CuKαのX 線回折スペクトルにおいてブラッグ角 (2 θ ± 0 . 2 度) の7. 5度、24. 2度および27. 3度に主な回 折ピークを有するフタロシアニン組成物に関する。

【0016】また、本発明は、チタニルフタロシアニン および中心金属が3価のハロゲン化金属フタロシアニン を含むフタロシアニン混合物を、アシッドペースティン グ法により水中に沈殿させ、CuKαのX線回折スペク トルにおいてブラッグ角 (2 θ ± 0. 2度) 27. 2度 に特徴的な回折ピークを有する沈殿物を得、引き続きこ の沈殿物を、芳香族系有機溶剤-水の混合溶媒で処理す ることを特徴とするCuΚαのX線回折スペクトルにお いてブラッグ角 (2θ±0.2度) の7.5度、24. 2度および27.3度に主な回折ピークを有するフタロ シアニン組成物の製造法に関する。

【0017】また、本発明は、導電性基材上に有機光導 電性物質を含有する光導電層を有する電子写真感光体に おいて、この有機光導電性物質がC u K αのX線回折ス ペクトルにおいてブラッグ角( $2\theta\pm0$ . 2度)の7. 5度、24.2度および27.3度に主な回折ピークを 有するフタロシアニン組成物である電子写真感光体に関 する。

【0018】また本発明は、前記の製造法により得られ たフタロシアニン組成物を含有する電荷発生層用塗液に 関する。

【0019】以下、本発明について詳述する。

【0020】一般に、フタロシアニン混合物とは、原料 に用いた2種以上のフタロシアニンの単なる物理的混合 物であり、フタロシアニン混合物のX線回折パターン は、原料に用いたそれぞれのフタロシアニン単体のピー クパターンの重ね合わせからなる。一方、本発明のフタ ロシアニン組成物とは、原料に用いたフタロシアニンが 分子レベルで混合したもので、X線回折パターンは、原 料に用いたそれぞれのフタロシアニン単体のピークパタ ーンの重ね合わせとは異なるパターンを示す。

【0021】本発明で用いられるチタニルフタロシアニ ンは、例えば、次のようにして製造することができる。 【0022】フタロニトリル18.4g(0.144モ ル) をαークロロナフタレン120ml中に加え、次に窒 素雰囲気下で四塩化チタン4ml (0.0364モル)を 滴下する。滴下後、昇温し撹拌しながら200~220 ℃で3時間反応させた後、100~130℃で熱時ろ過 して、αークロロナフタレン、ついでメタノールで洗浄 する。140mlのイオン交換水で加水分解(90℃、1 時間)を行い、溶液が中性になるまでこの操作を繰り返 し、メタノールで洗浄する。 次に、100℃のNMPで 充分に洗浄し、続いてメタノールで洗浄する。このよう にして得られた化合物を60℃で真空加熱乾燥してチタ ニルフタロシアニンが得られる(収率46%)。

【0023】本発明で用いられる中心金属が3価のハロゲン化金属フタロシアニンにおいて中心金属としての3価の金属は、In、Ga、Al等が挙げられハロゲンとしては、Cl、Br等が挙げられ、またフタロシアニン環にハロゲン等の置換基を有していてもよい。この化合物は公知の化合物であるが、これらのうち、例えば、モノハロゲン化金属フタロシアニンおよびモノハロゲン化金属ハロゲンフタロシアニンおよびモノハロゲン化金属ハロゲンフタロシアニンの合成法は、インオーガニックケミストリー(Inorganic Chemistry),19、3131(1980)および特開昭59-44054号公報に記載されている。

【0024】モノハロゲン化金属フタロシアニンは、例えば、次のようにして製造することができる。フタロニトリル78.2ミリモルおよび三ハロゲン化金属15.8ミリモルを二回蒸留し脱酸素したキノリン100ml中に入れ、0.5~3時間加熱還流した後徐冷、続いて0℃まで冷した後ろ過し、結晶をメタノール、トルエン、ついでアセトンで洗浄した後、110℃で乾燥する。【0025】また、モノハロゲン化金属ハロゲンフタロ

【0025】また、モノハロゲン化金属ハロゲンフタロシアニンは、次のようにして製造することができる。フタロニトリル156ミリモルおよび三ハロゲン化金属37.5ミリモルを混合して300℃で、溶融してから0.5~3時間加熱してモノハロゲン化金属ハロゲンフタロシアニンの粗製物を得、これをソックスレー抽出器を用いて $\alpha$ -クロロナフタレンで洗浄する。

【0026】本発明において、チタニルフタロシアニンおよび中心金属が3価のハロゲン化金属フタロシアニンを含むフタロシアニン混合物の組成比率は、帯電性、暗減衰、感度等の電子写真特性の点からチタニルフタロシアニンの含有率が、20~95重量%の範囲であることが好ましく、50~90重量%の範囲が特に好ましく、75~90重量%の範囲であることが最も好ましい。

【0027】フタロシアニン混合物はアシッドペーステ ィング法により水中に沈殿させアモルファス化される。 例えば、フタロシアニン混合物1gを濃硫酸50mlに溶 解し室温で撹拌した後、これを氷水で冷却したイオン交 換水1リットル中に約1時間、好ましくは40分~50 分で滴下し沈殿させる。一晩放置後、デカンテーション により上澄み液を除去した後、遠心分離により沈殿物を 回収する。その後洗浄水としてのイオン交換水で、洗浄 水の洗浄後のpHが2~5、好ましくはpHが3前後でかつ 伝導率が5〜500 $\mu$ S/cmとなるまで沈殿物を繰り返し 洗う。ついでメタノールで充分に洗浄した後、60℃で 真空加熱乾燥し粉末を得る。このようにして生成するチ タニルフタロシアニンと中心金属が 3 価のハロゲン化金 属フタロシアニンからなる沈殿物の粉末は、そのCuK  $\alpha$ のX線回折スペクトルにおいてブラッグ角(2 $\theta$   $\pm$ 0.2度)の27.2度に明瞭な回折ピークを示す以外

は、ピークが幅広くなっており明確にその値を規定できない。 pHが5を超えると、 $CuK\alpha$ のX線回折スペクトルにおいてブラック角( $2\theta\pm0$ . 2度)の27. 2度の特徴的なピーク強度が低下し、新たに6. 8度に27. 2度の特徴的なピーク強度より強いピークが生じ、この粉末を芳香族系有機溶剤ー水の混合溶媒を用いて結晶変換を行っても、本発明のブラッグ角( $2\theta\pm0$ . 2度)の7. 5度、24. 2度及び27. 3度に特徴的なピークを有する組成物を得ることはできず、この特徴的ピークを有しない組成物は感度が劣る。洗浄水の洗浄後のpHが2未満または5を超える場合は、帯電性、暗減衰、感度等が劣る傾向がある。

【0028】このようにして得られた沈殿物を芳香族系 有機溶剤-水の混合溶媒で処理することによって結晶変 換し、本発明のフタロシアニン組成物を得ることができ る。芳香族系有機溶剤と水の使用割合は、結晶変換効率 の点から、芳香族系有機溶剤/水(重量比)が1/99  $\sim$ 99/1であることが好ましく、50/50 $\sim$ 99/1 であることがより好ましい。また、水に対する沈殿物 の量は、1~50重量%であることが好ましい。本処理 は、20℃~100℃の芳香族系有機溶剤-水の混合溶 媒を沈殿物に1時間以上接触させることにより行うこと ができる。また、接触方法としては、スターラによる加 熱撹拌、または、ボールミル等によるミリングでもよ い。本処理に用いられる芳香族系有機溶剤としては、例 えばベンゼン、トルエン、キシレン等が挙げられる。 【0029】本発明のフタロシアニン組成物は、その吸 収スペクトルが、800~830nmの吸光度が、620 ~660nmの吸光度より大きいことが、感度の点から好

ましい。 【0030】本発明の電子写真感光体は、導電性支持体の上に光導電層を設けたものである。本発明において、 光導電層は、有機光導電性物質を含む層であり、有機光 導電性物質の被膜、有機光導電性物質と結合剤を含む被 膜、電荷発生層及び電荷輸送層からなる複合型被膜等が ある。

【0031】上記有機光導電性物質としては、上記フタロシアニン組成物が必須成分として用いられ、さらに公知のものを併用することができる。また、有機光導電性物質としては上記フタロシアニン組成物に電荷発生物質(電荷を発生する有機顔料)及び/又は電荷輸送性物質を併用することが好ましい。なお、上記電荷発生層には該フタロシアニン組成物及び/又は電荷発生物質(電荷を発生する有機顔料)が含まれ、電荷輸送層には電荷輸送性物質が含まれる。

【0032】上記電荷発生物質(電荷を発生する有機顔料)としては、アソキシベンゼン系、ジスアソ系、トリスアソ系、ベンズイミダソール系、多環キノン系、イン

ジゴイド系、キナクリドン系、ペリレン系、メチン系、 α型、β型、γ型、δ型、ε型、χ型等の各種結晶構造 を有する無金属タイプ又は金属タイプのフタロシアニン 系などの電荷を発生することが知られている顔料が使用 できる。これらの顔料は、例えば、特開昭47-375 43号公報、特開昭47-37544号公報、特開昭4 7-18543号公報、特開昭47-18544号公 報、特開昭48-43942号公報、特開昭48-70 538号公報、特開昭49-1231号公報、特開昭4 9-105536号公報、特開昭50-75214号公 報、特開昭53-44028号公報、特開昭54-17 732号公報等に開示されている。また、特開昭58-182640号公報及びヨーロッパ特許公開第92,2 55号公報などに開示されている $\tau$ 、 $\tau'$ 、 $\eta$ 及び $\eta'$ 型無金属フタロシアニンも使用可能である。このような もののほか、光照射により電荷担体を発生する有機願料 はいずれも使用可能である。

【0033】上記電荷輸送性物質としては、高分子化合物では、ポリーNービニルカルバソール、ハロゲン化ポリーNービニルカルバソール、ポリビニルピレン、ポリビニルインドロキノキサリン、ポリビニルベンゾチオフエン、ポリビニルアントラセン、ポリビニルアクリジン、ポリビニルピラソリン等が挙げられ、低分子化合物のものではフルオレノン、フルオレン、2,7ージニトローターフルオレノン、4Hーインデノ(1,2,6)チオフエンー4ーオン、3,7ージニトロージベンゾチオフエンー5ーオキサイド、1ープロムピレン、2ーフ

エニルピレン、カルバゾール、Nーエチルカルバゾー ル、3-フェニルカルパソール、3- (N-メチル-N ーフェニルヒドラゾン) メチルー 9 ーエチルカルバソー ル、2-フェニルインドール、2-フェニルナフタレ ン、オキサジアゾール、2, 5ービス(4ージエチルア ミノフェニル) -1, 3, 4-オキサジアゾール、1-フェニルー3ー(4ージエチルアミノスチリル)-5-(4ージエチルアミノスチリル) -5- (4ージエチル アミノフェニル) ピラゾリン、1-フェニルー3-(p -ジエチルアミノフェニル) ピラゾリン、p- (ジメチ ルアミノ)-スチルベン、2-(4-ジプロピルアミノ フェニル) ー4ー(4ージメチルアミノフェニル)-5 - (2-クロロフェニル) -1, 3-オキサゾール、2 ー (4ージメチルアミノフェニル) -4-(4-ジメチ ルアミノフェニル)-5-(2-フルオロフェニル)-1, 3-オキサゾール、2-(4-ジエチルアミノフェ ニル) -4- (4-ジメチルアミノフェニル) -5-(2-フルオロフェニル) -1, 3-オキサゾール、2 - (4ージプロピルアミノフェニル)-4-(4ージメ チルアミノフェニル)-5-(2-フルオロフェニル) ー1,3-オキサゾール、イミダゾール、クリセン、テ トラフェン、アクリデン、トリフェニルアミン、ベンジ ジン、これらの誘導体等がある。電荷輸送性物質として は、ベンジジン誘導体が好ましく、なかでも一般式

(I) 【化2】

$$(R_1)_{r}$$
 — A  $r_1$   $R_3$   $R_3$  A  $r_1$  —  $(R_1)_{p}$   $R_2$   $R_3$   $R_4$   $R_5$   $R_5$   $R_5$   $R_5$   $R_7$   $R_$ 

 $(R_1 \text{B} \text{U} R_2 \text{i}$ 、それぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、フルオロアルキル基又はフルオロアルコキシ基を表し、2個の $R_3 \text{i}$ 、それぞれ独立して水素原子又はアルキル基を表し、Ar<sub>1</sub>及びAr<sub>2</sub>は、それぞれ独立してアリール基を表し、p、q、r及びsは、それぞれ独立して $0\sim5$ の整数を示す)で表されるベンジジン誘導体が好ましい。一般式 [1] において、アルキル基としては、メチル基、エチル基、nープロピル基、isoープロピル基、nープチル基、tertープチル基等が挙げられる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、nープロポキシ基、isoープロポキシ基等が挙げられる。アリール基としては、フェニル基、トリル基、ビフェニル基、ターフェニル基、ナフチル基等が挙げられる。フルオロアル

キル基としては、トリフルオロメチル基、トリフルオロエチル基、ヘプタフルオロプロピル基等が挙げられる。フルオロアルコキシ基としては、トリフルオロメトキシ基、2,3ージフルオロエトキシ基、2,2,2ートリフルオロエトキシ基、1H、1Hーペンタフルオロプロポキシ基、1H、1Hーペンタフルオロブトキシ基、2,2,3,4,4,4ーヘキサフルオロブトキシ基、4,4,4ートリフルオロブトキシ基等のフルオロアルコキシ基が挙げられる。一般式[I]で表されるベンジジン誘導体としては、具体的には下記のNo.1~No.6の化合物等が挙げられる。

【0034】 【化3】

$$CH_3$$
 $H_3$ 
 $C$ 
 $NO. 1$ 
 $CF_3CH_2O$ 
 $NO. 2$ 
 $OCH_2CF_3$ 

$$H_3C$$

$$NO. 3$$

$$CF_3CH_2O$$

【化4】

CF.CH2O

【0035】上記フタロシアニン組成物及び必要に応じて用いる電荷発生物質(電荷を発生する有機類料)(両方で前者とする)と電荷輸送性物質(後者とする)とを混合して使用する場合(単層型の光導電層を形成する場合)は、後者/前者が重量比で10/1~2/1の割合で配合するのが好ましい。このとき、結合剤をこれらの化合物全量(前者+後者)に対して0~500重量%、特に30~500重量%の範囲で使用するのが好ましい。これらの結合剤を使用する場合、さらに、可塑剤、流動性付与剤、ピンホール抑制剤等の添加剤を必要に応じて添加することができる。

【0036】電荷発生層及び電荷輸送層からなる複合型の光導電層を形成する場合、電荷発生層中には、上記フタロシアニン組成物及び必要に応じて電荷発生物質(電荷を発生する有機額料)が含有され、結合剤をフタロシアニン組成物と電荷発生物質の総量に対して500重量%以下の量で含有させてもよく、また、上記した添加剤を該フタロシアニン組成物と電荷発生物質の総量に対して5重量%以下で添加してもよい。また、電荷輸送層には、上記した電荷輸送性物質が含有され、さらに、結合

剤を該電荷輸送性物質に対して500重量%以下で含有 させてもよい。電荷輸送性物質が低分子量化合物の場合 は、結合剤を該化合物に対して50重量%以上含有させ ることが好ましい。

【0037】上記した場合すべてに使用し得る結合剤としては、シリコーン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ポリケトン樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリアクリル樹脂、ポリスチレン樹脂、メラミン樹脂、メラミン樹脂、スチレンーブタジエン共重合体、ポリメタクリル酸メチル樹脂、ポリ塩化ビニル、エチレン一酢酸ビニル共重合体、ポリアクリルでラゾリン、ポリビニルロアミド樹脂、ポリビニルカルバゾール、ポリビニルピラゾリン、ポリビニルでというが挙げられる。また、熱及び/又は光によって架橋される熱硬化型樹脂及び光硬化型樹脂も使用できる。いずれにしても絶縁性で通常の状態で被膜を形成しうる樹脂並びに熱及び/又は光によって硬化し被膜を形成する樹脂であれば特に制限はなり、

【0038】上記添加剤としての可塑剤としては、ハロ

ゲン化パラフィン、ジメチルナフタリン、ジブチルフタ レート等が挙げられ、流動性付与剤としては、モダフロ ー(モンサントケミカル社製)、アクロナール4F(バ ズフ社製)等が挙げられ、ピンホール抑制剤としては、 ベンソイン、ジメチルフタレート等が挙げられる。これ らは適宜選択して使用され、その量も適宜決定されれば よい。

【0039】本発明において導電性基材とは、導電処理 した紙又はプラスチツクフィルム、アルミニウムのよう な金属箔を積層したプラスチツクフィルム、金属板等の 導電体である。

【0040】本発明の電子写真感光体は、導電性基材の 上に光導電層を形成したものである。光導電層の厚さは 5~50μmが好ましい。光導電層として電荷発生層及 び電荷輸送層の複合型を使用する場合、電荷発生層は好 ましくは $0.001\sim10\mu$ m、特に好ましくは0.2 $\sim 5 \, \mu \, \mathrm{m}$ の厚さにする。  $0 \, . \, \, 0 \, 0 \, 1 \, \mu \, \mathrm{m}$ 未満では、電荷 発生層を均一に形成するのが困難になり、10μmを越 えると、電子写真特性が低下する傾向がある。電荷輸送 層の厚さは好ましくは $5\sim50\,\mu\,\mathrm{m}$ 、特に好ましくは8 $\sim 25 \, \mu \, \mathrm{m}$ である。 $5 \, \mu \, \mathrm{m}$ 未満の厚さでは、初期電位が 低くなり、 $50\mu$ mを越えると、感度が低下する傾向が

【0041】導電性基材上に、光導電層を形成するに は、有機光導電性物質を導電性基材に蒸着する方法、有 機光導電性物質及び必要に応じその他の成分をトルエ ン、キシレン等の芳香族系溶剤、塩化メチレン、四塩化 炭素等のハロゲン化炭化水素系溶剤、メタノール、エタ ノール、プロパノール等のアルコール系溶剤、テトラヒ ドロフラン、2ーメトキシエタノール、2ーエトキシエ タノール、2ープトキシエタノール、等のエーテル系溶 剤などに均一に溶解又は分散させて光導電層用塗料とし 導電性基材上に塗布し、乾燥する方法などがある。塗布 法としては、スピンコート法、浸漬法等を採用できる。 電荷発生層及び電荷輸送層を形成する場合も同様に電荷 発生層用塗液及び電荷輸送層用塗液を調整し行うことが できるが、この場合、電荷発生層と電荷輸送層は、どち らを上層としてもよく、電荷発生層を二層の電荷輸送層 ではさむようにしてもよい。

【0042】本発明におけるフタロシアニン組成物をス ピンコート法により塗布する場合、フタロシアニン組成 物と必要に応じて用いる結合剤とをクロロホルム、トル エン、テトラヒドロフラン、2-エトキシエタノール等 の溶剤に溶かして得た塗布液を用いて回転数500~4 000rpmでスピンコーティングすることが好ましく、 また、浸漬法によって塗布する場合には、フタロシアニ ン組成物と必要に応じて用いる結合剤とを上記溶剤にボ ールミル、超音波等を用いて分散させた塗液に導電性基

板を浸漬することが好ましい。 【0043】本発明に係る電子写真感光体は、更に、導

電性基材のすぐ上に薄い接着層又はバリア層を有してい てもよく、表面に保護層を有していてもよい。

#### [0044]

【実施例】以下、フタロシアニン組成物の製造例、実施 例によって、本発明を詳細に説明する。

#### 【0045】製造例1

チタニルフタロシアニン0.75gおよび塩化インジウ ムフタロシアニン 0. 25gからなるフタロシアニン混 合物1gを硫酸50mlに溶解し室温で30分撹拌した 後、これを氷水で冷却したイオン交換水1リットルに、 約40分で商下し再沈させた。さらに冷却下で1時間撹 **拌後、一晩放置した。デカンテーションにより上澄み液** を除去後、遠心分離により沈殿物を分離し、700mgの 沈殿物を得た。1回目の充浄として、沈殿物700mgに 洗浄水としてのイオン交換水120m1を加え撹拌し、次 いで、遠心分離により沈殿物と洗浄水を分離除去した。 同様の洗浄操作をさらに5回続けて行った。6回目の操 作における分離除去した洗浄水(すなわち洗浄後の洗浄 水)のpH及び伝導率を測定した(23℃)。pHの測定に は、横河電機社製モデルPH51を使用した。また、伝 導率の測定は、柴田科学器械工業社製モデルSC-17 Aを使用した。洗浄水のpHは3.3であり、伝導率は、 65. 1 μS/cmであった。その後、メタノール 6 0 mlで 3回洗浄した後60℃で4時間真空加熱乾燥した。この 該乾燥物のX線回折スペクトルを図1に示した。つぎに この真空乾燥物1.0gにイオン交換水9.0g及びト ルエン86gを加え、60℃で8時間加熱撹拌し、遠心 分離を行い上澄み液を除去後、メタノールで洗浄して6 0℃で4時間真空加熱乾燥し、本発明におけるフタロシ アニン組成物の結晶を得た。この結晶のX線回折スペク トルを図2として示した。

#### 【0046】製造例2

製造例1と同様にして得られた真空乾燥物1.0gにイ オン交換水9.0gおよびキシレン86.0gを加え、 60℃で8時間加熱撹拌し、本発明におけるフタロシア ニン組成物の結晶を得た。この結晶のX線回折スペクト ルを図3に示した。

### 【0047】製造例3

製造例1と同様にして得られた真空乾燥物1.0gにイ オン交換水9.0gおよびベンゼン87.0gを加え、 60℃で8時間加熱撹拌し、本発明におけるフタロシア ニン組成物の結晶を得た。得られた組成物のX線回折ス ペクトルは図2と同じであった。

#### 【0048】製造例4

製造例1と同様にして得られた真空乾燥物1.0gにイ オン交換水9.0gおよびトルエン86.0gを加え、 ガラス瓶で1㎜φのジルコニアビーズとともに室温で2 0時間ボールミルミリングを行い、本発明におけるフタ ロシアニン組成物の結晶を得た。得られた組成物のX線 回折スペクトルは図2と同じであった。

## 【0049】製造例5

製造例1と同様にして得られた真空乾燥物1.0gにイ オン交換水100.0gおよびトルエン86.0gを加 え、60℃で8時間加熱撹拌し、本発明におけるフタロ シアニン組成物の結晶を得た。得られた組成物のX線回 折スペクトルは図2と同じであった。

#### 【0050】製造例6

製造例1と同様にして得られた真空乾燥物1.0gにイ オン交換水1.0gおよびトルエン86.0gを加え、 60℃で8時間加熱撹拌し、本発明におけるフタロシア ニン組成物の結晶を得た。得られた組成物のX線回折ス ペクトルは図2と同じであった。

## 【0051】製造例7

製造例1と同様にして得られた真空乾燥物1.0gにイ オン交換水9.0gおよびトルエン8.6gを加え、6 0℃で8時間加熱撹拌し、本発明におけるフタロシアニ ン組成物の結晶を得た。得られた組成物のX線回折スペ クトルは図2と同じであった。

#### 【0052】製造例8

製造例1と同様にして得られた真空乾燥物1.0gにイ オン交換水100.0gおよびトルエン1.7gを加 え、60℃で8時間加熱撹拌し、本発明におけるフタロ シアニン組成物の結晶を得た。得られた組成物のX線回 折スペクトルは図2と同じであった。

## 【0053】比較製造例1

製造例1と同様にして得られた真空乾燥物1.0gにト ルエン86.0gを加え、100℃で1時間加熱撹拌 し、フタロシアニン組成物の結晶を製造した。得られた 結晶X線回折スペクトルを図4に示した。

## 【0054】比較製造例2

図1の真空乾燥物の代わりに図5のX線回折スペクトル を示すフタロシアニン組成物を用いた以外は製造例1同 様にしてフタロシアニン組成物の結晶を製造した。得ら れた結晶のX線回折スペクトルを図6に示した。

## 【0055】製造例9~16

製造例1~8において塩化インジウムフタロシアニンの 代わりに臭化インジウムフタロシアニンを用いた以外は 製造例1~8に準じてフタロシアニン組成物の結晶を得 た。

## 【0056】比較製造例3、4

比較製造例1、2において塩化インジウムフタロシアニ ンの代わりに臭化インジウムフタロシアニンを用いた以 外は比較製造例1、2に準じてフタロシアニン組成物の 結晶を得た。

## 【0057】製造例17~24

製造例1~8において塩化インジウムフタロシアニンの 代わりに塩化ガリウムフタロシアニンを用いた以外は製 造例1~8に準じてフタロシアニン組成物の結晶を得

## 【0058】比較製造例5、6

比較製造例1、2において塩化インジウムフタロシアニ ンの代わりに塩化ガリウムフタロシアニンを用いた以外 は比較製造例1, 2に準じてフタロシアニン組成物の結 晶を得た。

## 【0059】製造例25~32

製造例1~8において塩化インジウムフタロシアニンの 代わりに塩化アルミニウムフタロシアニンを用いた以外 は製造例1~8に準じてフタロシアニン組成物の結晶を

## 【0060】比較製造例7、8

比較製造例1、2において塩化インジウムフタロシアニ ンの代わりに塩化アルミニウムフタロシアニンを用いた 以外は比較製造例1、2に準じてフタロシアニン組成物 の結晶を得た。

#### 【0061】実施例1

製造例1で製造したフタロシアニン組成物1.5g、ポ リビニルブチラール樹脂エスレックBL-S(積水化学 社製)0.9g、メラミン樹脂ML351W(日立化成 工業社製) 0.1g、2-エトキシエタノール49.0 g及びテトラヒドロフラン49.0gを配合し、ポール ミルで分散した。得られた分散液を浸漬法によりアルミ ニウム板(導電性基材100㎜×100㎜×0.1㎜) 上に塗工し、1 4 0℃で1時間乾燥して厚さ0. 5 µ m の電荷発生層を形成した。また、この分散液をガラス板 に塗布し、吸収スペクトルを測定した結果を図7に示し た。吸収スペクトルは日立製作所製U-3410形自記 分光光度計により測定した。前記のNo. 4の電荷輸送 性物質1.5g、ポリカーボネート樹脂ユーピロンS-3000 (三菱瓦斯化学社製) 1.5 g および塩化メチ レン15.5gを配合して得られた塗布液を上記アルミ ニウム基板上に浸漬法により塗工し、120℃で1時間 乾燥して厚さ20μmの電荷輸送層を形成した。電子写 真特性(感度、残留電位、暗減衰率、光応答性)は、シ ンシア30HC(緑屋電気社製)により評価した。コロ ナ帯電方式で感光体を一650Vまで帯電させ、780 nmの単色光を50mS感光体に露光し種々の特性測定を行 った。上記の特性の定義は、以下の通りである。感度 (E<sub>50</sub>) は、初期帯電電位-650Vを露光0.2秒後 に半減させるのに要する 7 8 0 nmの単色光の照射エネル ギー量であり、残留電位(Vr)は、同波長の20mJ/m <sup>2</sup>の単色光を50mS露光し、露光0.2秒後及び0.5 秒後に感光体の表面に残る電位である。暗滅衰率(DD R)は、感光体の初期帯電電位-650Vと初期帯電後 暗所 1 秒放置後の表面電位  $V_1$  (-V) を用いて  $(V_1/$ 650) ×100と定義した。光応答性(T<sub>1/2</sub>)は、 波長 7 8 0 nmの 2 0 mJ/m²の単色光を 5 0 mS露光し、初 期帯電電位ー650Vを半減させるのに要する時間(se c) と定義した。

## 【0062】実施例2~8

実施例1において製造例2~8で得られたチタニルフタ

ロシアニン組成物を用いた以外は実施例1に準じて電子 写真感光体を製造し評価した。その結果を表1に示し た。

【0063】比較例1、2

実施例1において比較製造例1、2で得られたチタニル フタロシアニン組成物を用いた以外は、実施例1に準じ て電子写真感光体を製造し評価した。その結果を表1に 示すが、見かけ上高感度に見えるが、暗減衰率が、実用 に耐える値ではなかった。比較製造例1で得られた粉末 を使用した分散液をガラス板に塗布し、吸収スペクトル を測定した結果を図8に示した。

【0064】比較例3

製造例1においてトルエンー水の混合溶媒で処理する前 の乾燥粉を用いた以外は、実施例1に準じて電子写真感 光体を製造し評価したが一650Vまで帯電することが できなかった。

[0065]

【表1】

		嵌						
	電荷発生物質	電荷輸送性物質	陽 (Eso)	残留電位 (Vr0.2) (-V)	残留電位 (Vr0.5) (-V)	語資類 (DDR) (%)	光56格性 (T 1/2) (aS)	
安佐區	製造例1で得た結晶	No. 4	2.2	3.1	2.8	98.3	9.2	
大記が ・ 一 を を を を を を を を を を を を を を を を を を	製造例2で得た結晶	No. 4	2.4	3.7	3.4	97.0	9.4	
X MAH	配治例3で得た結晶	No. 4	2.2	5.4	38	95.7	15.4	
米国が、	気に のいません おり の は の は の は の は の は の は の は た 結 晶	4 .0 N	2. 1	3 5	3.2	94.4	11.0	
米 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_	No. 4	2.5	2 8	2 2	97.3	10.2	
実施例ら	が回路	0	2.0	3.2	2 5	96.0	8.4	
英施例 6	-		1	0 %	4 1	97.5	10.4	
実施例7	製造例7で得た結晶	No. 4	4	1	1.	\ \	- 1	
班格風8	3 製造例8で得た結晶	No. 4	2.3	2 4	3.2	4 . 4		
Lab. Au	1	No. 4	1.8	5 1	3 2	59.3	14.0	
九天			-	- 1 8	100	67.	9 20.0	
元 数 函	2 比較製造例2で得た結晶	No. 4	4.0	<b>)</b>	1	- 4		T
た数型の	3 製造例1で得た乾燥粉	No. 4		辞	電能刀	<b>4</b>		
					•			

【0066】実施例9~16

実施例1において製造例9~16で得られたチタニルフ タロシアニン組成物を用い、かつ、電荷輸送材料として No. 4の化合物の代わりにNo. 2を用いた以外は実 施例1~8に準じて電子写真感光体を製造し評価した。 その結果を表2に示した。

【0067】比較例4、5

実施例1において比較製造例4、5で得られたチタニル フタロシアニン組成物を用い、かつ、電荷輸送材料とし てNo. 4の化合物の代わりにNo. 2を用いた以外 は、実施例1に準じて電子写真感光体を製造し評価し た。その結果を表2に示した。

【0068】比較例6

製造例9においてトルエンー水の混合溶媒で処理する前

の乾燥粉を用いた以外は、実施例1に準じて電子写真感 光体を製造し評価したが、一650Vまで帯電すること ができなかった。

[0069] 【表 2 】

		嵌	7				
	電荷発生物質	電荷輸送性物質	(E)(E)	残留電位 (Vr0.2) (-V)	残留電位 (Vr0.5) (-V)	<b>忠資版</b> (DDR) (%)	光 <b>5</b> 络在 (T1/2)
中村回 0	製造例9で得た結晶	No. 2	1.9	3.9	3 0	93.7	9.2
大馬四次 金括 三元 一	製造例10で得た結晶	No. 2	1.8	3 8	2.7	92.5	10.1
X Marxin	製造側11で得た結晶	No. 2	1.9	43	3 1	93.8	12.3
1120001	数角型 256 年 大路 国	No. 2	1.6	3 5	2.8	90.8	9.8
A SERVICE	文元の1978年18日本第四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	No. 2	1.3	2 8	2 1	97.3	9. 2
<b>東題例13</b>	は、大型のTO CITA では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	Z 2	1.9	3 2	2 5	97.8	6.6
実施例14	製造例14で存ん配用				2 2	94.7	11.4
実施例15	製造例15で得た結晶	No. 2	1.4	4 1		:	\ ,
五七五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	観告例16で得た結晶	No. 2	1.5	3	2 9	94.6	1 0. 0
大馬を	-	No. 2	1.8	5 3	3.4	60.7	13.7
<b>比較愈4</b>	万数数回约4 C中心由出				× 2	8.0.1	18.7
九穀囪 5	比較製造例5で得た結晶	No. 2	4.8	x x	+	$\left. \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \end{array} \right  .$	
比較例 6	製造例9で得た乾燥粉	No. 2	·	辞	第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	جو   ا	

【0070】実施例17~24

実施例1において製造例17~24で得られたチタニル フタロシアニン組成物を用い、かつ、電荷輸送材料とし てNo. 4の化合物の代わりにNo. 5を用いた以外は 実施例1~8に準じて電子写真感光体を製造し評価し た。その結果を表3に示した。

【0071】比較例7、8

実施例1において比較製造例7、8で得られたチタニル

フタロシアニン組成物を用い、かつ、電荷輸送材料とし てNo. 4の化合物の代わりにNo. 5を用いた以外 は、実施例1に準じて電子写真感光体を製造し評価し た。その結果を表3に示した。

【0072】比較例9

製造例17においてトルエンー水の混合溶媒で処理する

前の乾燥粉を用いた以外は、実施例1に準じて電子写真 感光体を製造し評価したが、 - 650 Vまで帯電するこ とができなかった。

[0073]

【表3】

	•						
	電荷発生物質	電荷輸送性物質	廢废 (Eso) (mJ/m)	残留電位 (Vr0.2) (-V)	残留電位 (Vr0.5) (-V)	暗滅衰 (DDR) (%)	光56格在 (T1/2) (mS)
1	国光面176.绝大馆品	No. 5	1.8	3.9	3 0	98.3	6.9
吳麗例17	※回答は、 では、 は、 は	No. 5	1.9	4 1	3.0	97.7	6.7
実施例18	製造例10で存ん相間		0	0 4	4.8	98.9	10.7
実施例19	製造例19で得た結晶	No. 5	0	1			
中地位の	戦略例20で得た結晶	No. 5	2.0	4 2	3 2	96.9	10.0
0764日		4 o M	2.7	3.7	2 9	97.3	თ
実施例21	製造例21でやた桁間	;		- 1		0 9 0	6
电描图22	製造例22で得た結晶	No. 4	2.0	3 5	0 7		;
2750 200		4 0 N	2.6	4 4	3.7	97.7	12.
実施例23	製剤を25に存んた品			9.0	2.5	98.4	111.
実施例24	製造例24で得た結晶	No. 4	2.5	1	1		<u> </u>
8	しまを選出回れる個と結晶	No. 5	1.8	37	2 9	57.8	1 3.
<b>拓製室</b>	な数がはなっている。					7.3	2
<b>光較</b> 8	比較製造例6で得た結晶	品 No. 5	4.2	7.7	0		
4	を は は は に に に に に に に に に に に に に	No. 5		布	龍力	なっ	

【0074】実施例25~32

実施例1において製造例25~32で得られたチタニル

フタロシアニン組成物を用い、かつ、電荷輸送材料とし てNo. 4の化合物の代わりにNo. 1を用いた以外は 実施例1~8に準じて電子写真感光体を製造し評価し た。その結果を表4に示した。

【0075】比較例10、11

実施例1において比較製造例10、11で得られたチタ ニルフタロシアニン組成物を用い、かつ、電荷輸送材料 としてNo.4の化合物の代わりにNo.1を用いた以 外は、実施例1に準じて電子写真感光体を製造し評価し た。その結果を表4に示した。

【0076】比較例12

製造例25においてトルエン-水の混合溶媒で処理する 前の乾燥粉を用いた以外は、実施例1に準じて電子写真 感光体を製造し評価したが、 - 6 5 0 Vまで帯電するこ とができなかった。

[0077]

【表4】

		崧	4					
	電荷発生物質	電荷輸送性物質	廢庶 (E50)	残留電位 (Vr0.2) (-V)	残留電位 (Vr0.5) (-V)	暗滅療 (DDR) (%)	光芍谷在 (T1/2)	
					G.	α α	9.3	
事権例25	製造例25で得た結晶	No. 4	2. 1	4 1		;		
36 M 34 44		No. 4	2.2	4 3	3.4	96.3	9.7	
米局如20	No. of the state o	4 o M	2.1	4 6	3 8	95.5	11.1	
実施例27	製造例27で待た棺間	.			6	0 R	10.7	
宝瓶例28	製造例28で得た結晶	No. 4	2.0	3.7	0 0		;	
	all Arcelons 個大社區	No. 4	2.3	2 1	1 5	98.3	11.2	
実施例29	数位例23 Cでいる MB BB			c,	2.7	97.0	9.9	
<b>実施例30</b>	製造例30で得た結晶	No. 4	2. 4	1				1
	国は十多名に日本語	Z . o Z	2. 1	4 0	3.4	9 7 6	1 2. 4	- 1
<b>実施例31</b>	製荷倒31で存んで四日			86	1 9	95.9	10.0	
実施例32	製造例32で得た結晶	No. 4	7.7			0 4	15.3	
L 數/周10	平断製造例7で得た結晶	品 No. 4	1.9	သ	4 0	; \		- 1
10年2010			4	8 8	9 2	54.	9 15.3	_
上較例11	比較製造例8で得た結晶	* · O Z	.	.	٦	<u> </u>		ı
<b>比較倒16</b>	製造例13で得た乾燥粉	No. 4		10000000000000000000000000000000000000	콾	- 1		1

[0078]

【発明の効果】本発明のフタロシアニン組成物を用いた 電子写真感光体は、帯電性、暗減衰、感度等の電子写真 特性が優れており、従来よりも更に高密度、高画質が要 求される電子写真プロセスに好適に応用することができ

【図面の簡単な説明】

【図1】製造例1において得られた真空乾燥物のX線回 折スペクトル。

【図2】製造例1において得られたフタロシアニン組成 物のX線回折スペクトル。

【図3】製造例2において得られたフタロシアニン組成 物のX線回折スペクトル。

【図4】比較製造例1において得られたフタロシアニン

組成物のX線回折スペクトル。

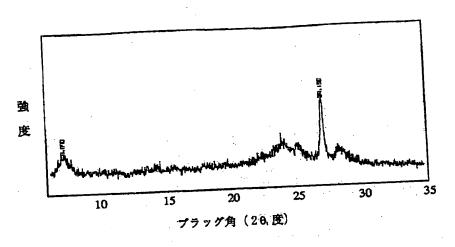
【図5】比較製造例2において用いた真空乾燥物のX線 回折スペクトル。

【図6】比較製造例2において得られたフタロシアニン 組成物のX線回折スペクトル。

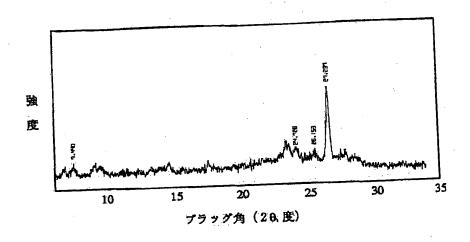
【図7】実施例1において得られた分散液の吸収スペク

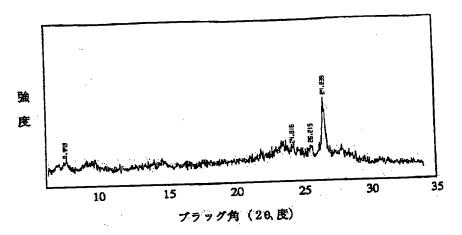
【図8】比較例1において得られた分散液の吸収スペク トル。

【図1】

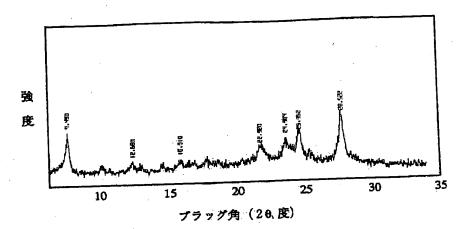


【図2】

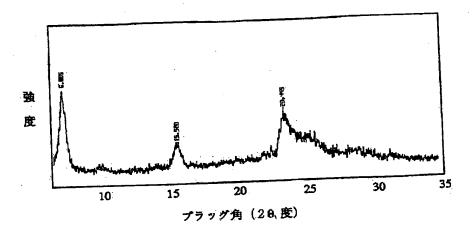




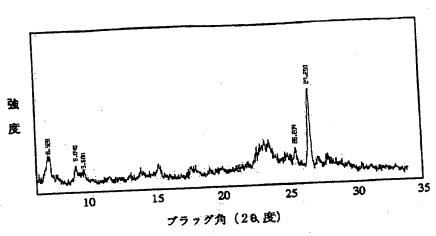
【図4】



【図5】

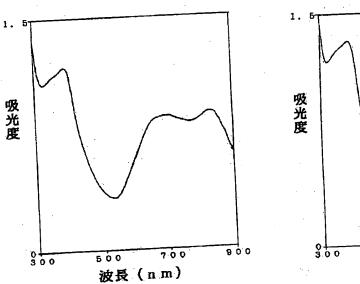


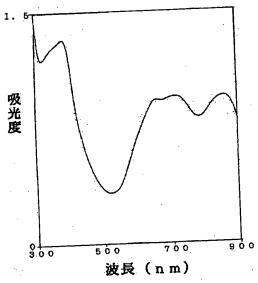
【図6】



[図7]

【図8】





フロントページの続き

(72)発明者 板垣 幹男 茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社茨城研究所内